

СОДЕРЖАНИЕ

Кукушкин С. А. Специальный выпуск журнала «Конденсированные среды и межфазные границы»: Новые материалы для микро-, нано- и оптоэлектроники: свойства, структура и механизмы роста	479	Бутенко П. Н., Тимашиов Р. Б., Степанов А. И., Печников А. И., Чикиряка А. В., Гузилова Л. И., Степанов С. И., Николаев В. И. Создание гетероструктуры $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3\text{:Sn}/\alpha\text{-Cr}_2\text{O}_3/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ методами газофазной эпитаксии	542
ОБЗОР Баранов С. А. Поверхностная энергия в микропроводах. Обзор	484	Каминский В. В., Калганов Д. А., Панов Д. Ю., Спиридонов В. А., Иванов А. Ю., Розаева М. В., Бауман Д. А., Романов А. Е. Исследование оксида галлия методом составного пьезоэлектрического осциллятора на частоте 100 кГц	548
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ Захаров А. Ю., Захаров М. А. Релятивистская модель межатомных взаимодействий в конденсированных системах	494	Осипов А. В., Шарофидинов Ш. Ш., Кремлева А. В., Смирнов А. М., Осипова Е. В., Кандаков А. В., Кукушкин С. А. Превращения фаз в процессе отжига пленок Ga_2O_3	557
Красницкий С. А., Смирнов А. М. Энергия парного взаимодействия пересекающихся дефектов дилатационного и дисклинационного типа	505	Пронин И. П., Каптелов Е. Ю., Гущина Е. В., Сенкевич С. В., Пронин В. П., Рыжов И. В., Уголков В. Л., Сергеева О. Н. Особенности кристаллизации и физических свойств тонкопленочной гетероструктуры цирконат-титанат свинца – оксид свинца	564
Бессолов В. Н., Коненкова Е. В., Орлова Т. А., Родин С. Н. Полуполярный GaN(11-22) на нанострукту- рированном Si(113): структура для снижения термических напряжений	514	Старицын М. В. Аномальное электронное каналирование в тонких пленках ЦТС	572
Гридчин В. О., Резник Р. Р., Котляр К. П., Кириленко Д. А., Драгунова А. С., Крыжановская Н. В., Цырлин Г. Э. Структурные и оптические свойства InGaN нитевидных нанокристаллов с градиентным химическим составом	520	Баранов С. А. Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения. Краткий обзор	581
Резник Р. Р., Гридчин В. О., Котляр К. П., Непloh В. В., Осипов А. В., Кукушкин С. А., Saket O., Tcherysheva M., Цырлин Г. Э. Подтверждение методом картирования тока, наведенного электронным пучком, самопроизвольного легирования GaN нитевидных нанокристаллов из вицинальной подложки SiC/Si	526	Манякин М. Д., Курганский С. И. Электронное строение диоксида германия со структурой рутила по данным ab initio компьютерного моделирования	587
Семенов А. Н., Нечаев Д. В., Трошков С. И., Березина Д. С., Арва Сауд Аббас, Жмерик В. Н. Микро- и наноструктуры GaN, селективно выращенные на профилированных подложках сапфира методом ПА-МПЭ без использования литографии	532	Плюснин Н. И. Твердый смачивающий слой, формирование межфазной границы и тонкопленочные наноматериалы. Краткий обзор Аннотации на английском языке	594 605